



中科海高
HiGaAs Microwave

V1.1

HGC151LLC4

GaAs MMIC
两路功分器, 0.8 - 2 GHz

F6

功分器
|
陶瓷

主要特点

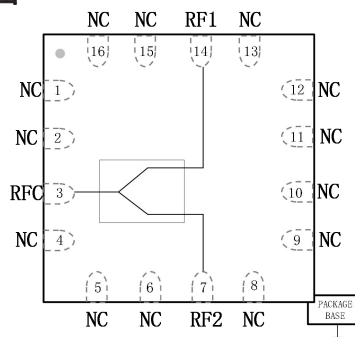
频率范围: 0.8 - 2GHz

插入损耗: 1.0 dB

输入/输出: 50 Ohm 匹配

陶封尺寸: 16Lead, 4 mm × 4 mm QFN

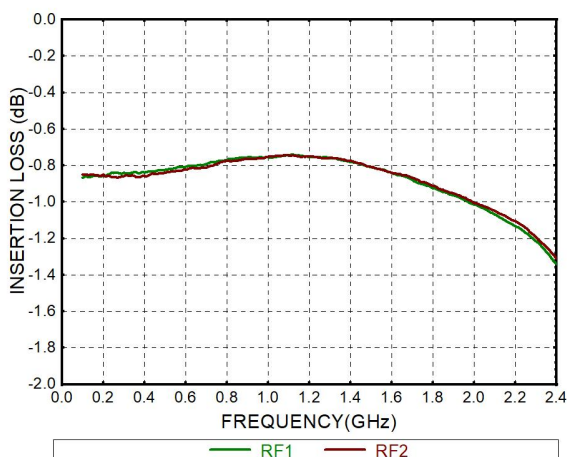
功能框图



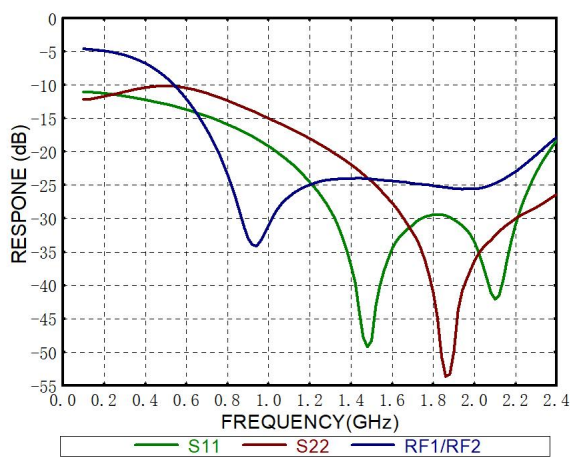
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $P_{in} = 0\text{dBm}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围		0.8 - 2		GHz
插入损耗		1.0		dB
平坦度		± 0.3		dB
隔离度		20		dB
回波损耗		20		dB

插入损耗



回波损耗与隔离度



引脚描述

引脚序号	功能	描述
3	RFC	该引脚是射频公共端
14	RF1	该引脚是射频支路端
7	RF2	该引脚是射频支路端
其余	NC	接地或悬空
底部中央焊盘	GND	底部中央焊盘必须连接至 RF/DC 地

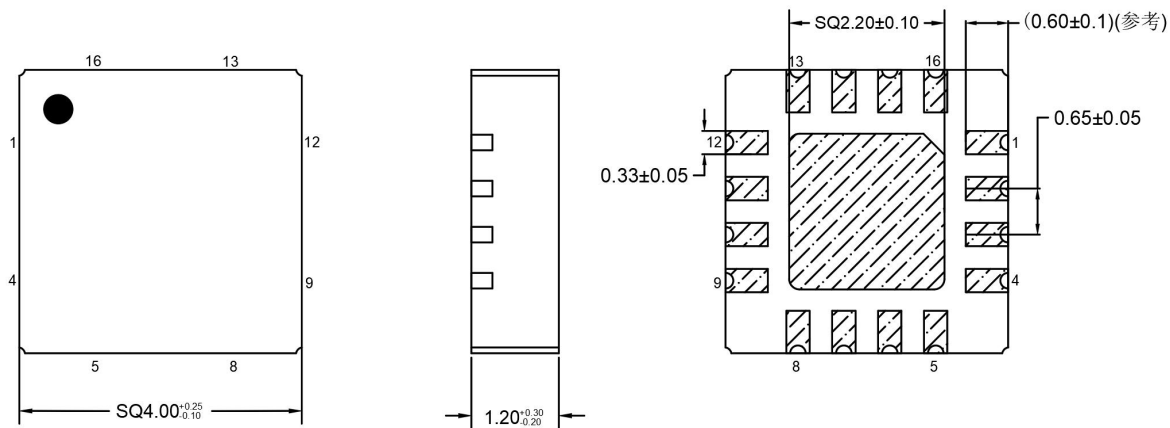
F6.1

成都市高新区百草路 898 号智能信息产业园 201-203 室
电话: 17313176116 028-64331356 022-66351597

天津市中新生态城中天大道 2018 号科技园 13 号楼 1 层
邮箱: support@higaas.com 网址: www.higaas.com

物理参数

单位: mm



注意事项:

1. 器件在干燥、氮气环境中存储;
2. 器件对静电敏感, 在储存、运输、储存、装配和使用过程中注意防静电;
3. 所有接地引脚请连接 RF 地;
4. 该产品适用于回流焊贴装工艺, 回流焊温度 $\leq 265^{\circ}\text{C}$, 回流焊使用时需要做去金预处理。

极限参数

1. 最大输入功率: +37 dBm
2. 存储温度: $-65 \sim +150^{\circ}\text{C}$
3. 工作温度: $-55 \sim +85^{\circ}\text{C}$

F6

功分器
陶封